This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-129261

(43)Date of publication of application: 09.10.1981

(51)Int.CI.

CO9D 3/16

CO8L 83/04

(21)Application number: 55-032735

HITACHI LTD

HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

17.03.1980

(72)Inventor:

(71)Applicant:

NAKATANI MITSUO

SHOJI FUSAJI

WATANABE TAKESHI SUDO RYOICHI YOKONO ATARU **ISOGAI TOKIO**

MATSUYAMA HARUHIKO

AZUMA KAZUFUMI

(54) THIN FILM-FORMING COATING LIQUID COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled compsn. which produces a good coating film which has a uniform thickness and is pinhole-free, and is suitable for use in the production of an insulating coating film, an oriented film, etc., by adding a specified amount of dimethylpolysiloxane to a soln. consisting of a ladder type organosilicon polymer and a solvent.

CONSTITUTION: 0.01W10wt% Dimethylpolysiloxane (C) is blended with a soln. consisting of 0.5W20wt% ladder type organosilicon polymer (A) having phenyl group [e.g. a polyphenylsilsesquioxane having a relative viscosity (in 1wt% benzene soln. at 30°C) of 1.1W3.0] and 99.5W80wt% solvent (B) having a b.p. of not lower than 180° C. By the blending of dimethylpolysiloxane, a coating film which is pinhole-free and has a uniform thickness, can be obtd. when the compsn is coated on the surfaces of glass, SiOx and metal oxides by printing method.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

. ①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—129261

⑤ Int. Cl.³C 09 D 3/16C 08 L 83/04

識別記号

庁内整理番号 7455-4 J 7019-4 J 砂公開 昭和56年(1981)10月9日発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

50薄膜形成用塗布液組成物

②特 願 昭55-32735

②出 願 昭55(1980)3月17日

⑫発 明 者 中谷光雄

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所生産技術研究

所内

⑫発 明 者 庄子房次

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑩発 明 者 渡辺猛志

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑫発 明 者 須藤亮一

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

最終頁に続く

剪 紙 書

- 1 発明の名称 薄膜形成用塗布液組成物
- 2 特許請求の範囲
 - (j) フェニル基を有するラダー型オルガノシリューンポリマーと、溶剤と、および配合比において 0.01~1.0 重量×のジメテルポリシロキサンとよりなることを特徴とする薄膜形成用強布液組成物。
 - (2) 酸フェニル基を有するラダー型オルガノシリコーンポリマーの配合比は 0.5~20重量 * , 該幣剤は沸点が 180で 以上のものにしてその 配合比は 80~9 9.5重量 * である特許請求の範囲 第1項配載の薄膜形成用盤布放組成物。
 - (a) 酸フェニル基を有するラダー型オルガノン リコーンポリマーは相対粘度(1重量×ベン セン密徹、30℃)が11~30のポリフェニ ルシルセキオキサン、ポリ(メタクロロフェ ニルシルセスキオキサン)、ポリ(ピフェニ ルシルセスキオキサン)、ポリ(フェニルジフェニルシルセスキオキサン)、ポリチタノ

フェニルシロキサン、ポリポロノフェニルシロキサンよりなる辞中より選ばれた少なくとも1種の化合物よりなるものである特許請求の範囲第1項または第2項配数の薄膜形成用途布液組成物。

3 発明の詳細な説明

本発明はフェニル基を有するラダー型のオル ガノシリコーンポリマーの存譲を印刷法で形成 するための重布被組成物に関するものである。

従来、絶縁被優材、半導体用保護膜、液晶表示案子用配向膜などの形成に使用される遠布液は、各種の重合体と各種の密剤とからなってもり、その用途によつて組成を異にしてるラダーのである。これまでフェニル差を有するラダーの型オルガノシリコーンボリマーとしてメタクロコールシルセスキオキサン)、ボリチタフェニルシルセスキオキサン)、ボリチタフェニルシャセスキオキサン)、ボリチタフェニルシャセスキオキサン)、ボリチタフェニルシャセン、ボリボロフェニルシャセン・ボリボロフェニルシャセン・ボリボロフェニルシャセン・ボリボロフェニルシャセン・ボークを強力を強力を強力を強力を強力を使用される。

サンなどの合成されている。また、これらの容 剤としてはペンセン、ジフェニル、ジフェニル オキサイド、メチルフェニルエーテル、エチル フェニルエーテル、シクロヘキサン、ペンゾニ トリル、メンテレン、デュレン、メタジメトキ シベンセン、トルエン、クロロペンセン、オル トシクロロペンセンなどが知られている。

本発明の目的は上記のような従来技術の欠点

フェルシロキサン , ポリポロノフェニルシロキ サンよりなる群中より過ばれた少なくとも 1 種 の化合物よりなるものである。

このような薄膜形成用強布液組成物を用いれば絶縁被覆膜,保護膜,配向膜などを印刷法により均一厚さのピンホールフリーのものとして得ることができるものである。

上記においての配合比を 0.5~2 0 重量× 、 移剤 で 5 ~2 0 重量× 、 移剤 で 6 0~9 9.5 重量× としたの配合比を 80~9 9.5 重量× としたの配合比を 80~9 9.5 重量× としたの配合比を 80~9 9.5 重量× としたの配合比を 0.0 配合比を 0.0 配合比を 0.0 配合比で 0.0 配合比で 0.0 では 0.0 を 0.0

をなくし、印刷法によつて厚さが均一でピンホールフリーの強膜を形成できるラダー型オルガノシリコーンポリマーの薄膜形成用塗布液組成物を提供するにある。

以上の目的のための本発明になる薄膜形成用 難布被組成物の特徴とするところは、フェニル 基を有するラダー型オルガノシリコーンポリマ ーと溶剤と, および配合比において QG1~10 重量×のジメチルポリシロキサンとよりなるも のである。好ましぐは,該フェニル基を有する ラダー型オルガノシリコーンポリマーの配合比 は 0.5~20 重量×, 該溶剤は沸点が 180t 以上に してその配合比は 80~925 重量 × であるものであ る。該フェニル基を有するラダー型オルガノシ リコーンポリマーとして好ましるのは、相对粘 度(1重量*ペンセン溶液,30℃)が11~300 ポリフエニルシルセスキオキサン、ポリ(メタ クロロフエニルシルセスキオキサン) , ポリ (ピフエニルシルセスキオキサン),ポリ(フェ ニルジフエニルセスキオキサン),ポリチョノ

<u>ه</u> که

本発明環膜形成用歯布液組成物においてジメ チルポリオルガノシロキサンを配合したのは、 ラダ型オルガノシリコーンポリマーを容解する **溶剤は積類が限定され、溶解する溶剤のいずれ** を用いた盤布板においても、特にガラス面、Si O 本面, 金属酸化物面に印刷法で塗布した場合に 必ずピンホールが発生してしまい,との問題解 決化対して各種材料の配合効果を調べた結果。 釜布板にジメチルポリオルガノシロキサンを配 合するのが最も良いことを見出したことによる。 また、その好ましい配合比を 0.01 重量 *~10 重量 * としたのは、 QD1重量 * 未満ではその配 合効果が得られないこと、およびジメチルポリ オルガノシロキサンを配合すると密剤のタダー 型オルガノシリコンポリマー溶解力が減少する 傾向にあり、10重量がをこれるとポリマーが析 出易く,均一重度が得られなくなることによる。

本発明において用いる好ましいラダー型オル ガノシリコーンポリマーを相対粘度が11~50と

特開昭56-129261(3)

したのは、11未満のものを用いて得られる乾燥強膜は腹強度が弱く実用的でないこと、および30を2えるものはいずれの溶剤を用いても液の粘度、降伏値が非常に高くなり、印刷した強膜が容易にレベリングせず、均一厚の膜が得られないことによる。

本発明において用いる好ましい溶剤を、その 沸点が180で以上のものとしたのは、180で未 濃の沸点の溶剤を用いた液を印刷した場合、印 刷された強膜が良好にレベリングしないことを 見出したことによる。

以下に本発明を実施例および比較例の試験例につき詳細に説明する。

試験例: 1~46

試験例1~46中,例1~11,12~23,24~36 ,38,42 は比較例にして本発明によらぬもの, 例37,39~41,43,46 は本発明の実施例である。

本試験例においては、相対粘度の異なる各種のラダー型オルガノシリコーンポリマー、各種の番別、各種の添加物につき、それらの配合比

を循々に変えた液よりなる、各種の本発明によ ちぬ比較例の場合、および本発明による実施例 の場合につき組成物を作成し、被の状態および 各種基板にフレキソ印刷法で印刷した重膜の厚 さの均一性、ピンホールの有無を調べた。また との強膜を 250 でで 30分間乾燥したのち、膜強 度をクロスカット試験法で評価した。それらの 組成物の組成およびそれらにより得られた結果 を第1~4回の表に示す。

第1 図の桜に示す比較例である試験例1~5 の結果から、厚さの均一性、膜強度に優れる強 膜を得るためには相対粘度が11~30 のポリフェンルシルセスキオキサンを用いる必要がある ことがわかる。このことは第1 図の表に示す比 較例である試験例 6~1 1からわかるように、他 のライダー型オルガノシリコーンポリマーにつ いても同様であつた。

第 2 回 の 扱 の 比 較 例 で あ る 試 験 例 1 2~1 4 1 に み ら れ る よ う に , ポ リ マ 一 過 度 が 20 重量 * を こ え る と 良 好 な 強 膜 を 得 る こ と が で き ぬ こ と が わ か

うた。

また、第2図の表の比較例である試験例15~ 23にみられるように、沸点が180で未満の密剤 を用いた塗布液では、いずれも均一厚さの盆膜 が得られず、180℃以上の沸点の溶剤を用いた **塗布液の場合は均一な厚さの盆膜が得られた。 歯膜のピンホールについてはポリマーと溶剤と** のみからなる第1図の表および第2図の表に示 す比較例である試験例1~24の強布液ではいずれ もその発生がみられた。このため、ピンホール 発生防止効果をみるため約130種類の化合物の 添加効果を調べた。第3図の表に示した試験例 24~37はその代表例である。 表からわかるよう に、ビンホール発生防止に対して効果のあつた 添加物はアクリルポリマー、シラン化合物、ジ メチルポリシロキサンだけであつた。しかしこ れらのうち、アクリルポリマーはその症加効果 が充分でなく完全にはピンホールの発生を防げ ない。また,シラン化合物はピンホール発生防 .止に対しては非常に有効であつたが、これを蘇

加した被を長時間放催しておくと液が白濁し易問題があつた。本発明組成物におけるビンホール防止効果の説明のために比較例として試験例24~56,実施例として試験例57を代表例として送んだのは上記の理由によるものである。

第4図の表に示した比較例である試験例 38,42,実施例である試験例 39~41 および 45~46 からわかるように,上記のピンホール防止効果のある旅加化合物であるポリシロキサンは,0.01重量*未満の配合量では充分な添加効果がなく、また 10重量*をこす配合量では塗布液の日潤を起こす。

以上の比較例かよび実施例である試験例1~46の結果から,本発明による構態形成用途布液 組成物が優れた塗護特性を与えることが実証された。なか,第4凶の姿にかける実施例45~46 にみられるように,本発明の塗布液組成物は各種の基板にかいても良好な塗膜が得られる。

以上の説明に明らかなように、本発明になる 薄膜形成用塗布液組成物を用いれば、各種基板 上に均一厚でビンホールがなく,膜強度に優れた強膜を形成できる。また,との強膜形成を印刷法でできるので,所望のパターンのものが1工程でできて,プロセスの簡略化,強布液の効率的使用が可能となる。それに加えて,上配の優れた特性をもつ膜が得られるので,絶級層,依贔配向膜形成などに用いたとき,その電子部品の信頼性を大幅に向上できる。とのよりにして本発明の効果は極めて大である。

4 図面の簡単な説明

第1 図,第2 図,第3 図,第4 図は本発明の 実施例およびそれに関係るる比較例の試験例に おける液組成,液の特性およびそれを用いた塗 膜の特性を示した表である。

代理人弁理士 薄田利、幸

#	(引 マ - (相対粘度)	ポリフスニルシルセスキ オキサン(L.O), 5mt第	がリフエニルシルセスキ オキサン(L.1), G単E名	ポリフエニルシルセスキ オキザン(j.47), Swt名	#1/7.x.z.z.z.z.e.z.t. 4442(3.0), 6#18	がリフエニルシルセスキ オキサン(35) 6mt名	#9 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	がリピフェニル シルセスキ オキサン(1.4),6mt第	6) (7x+n27x=n 0.n=x+4++1) (1.3), 6wt\$	ポリチタノフエニル シロササン (LB), 6mt 第	ボリボロノシロキサン (1.2) 6wt名	14438-592-5
6 被 和	(E (E) (E)	2 - アセチルシクロ ヘキサノン (22のU) 94mtの	- -	E	Æ	<u>10</u>	عن عن	- TE	臣	坦	巨	ند ات
₩		2 18										
,	にいち ・ ル防 氏	۵ ت	بة د	#	ام د	۾ ح	4 4	ئ ة ب	٦	ئ. ئ	ب ب	ئة ت
鄉	後の状態	cos .	40∜	ez.	40%	差	cas,	44	624	6 84	484	es.
##	#¥	S10x (好)~岁 ガラス版	五郎	间	闸上	I E	E T	祖	<u> </u>	更 7.	मुख	1
481	数数 の時一性	. c z	世	- 10 2	ध्य	# <u>*</u>	es .	=	œ	ex.	æ	es:
44	とものが、イングを	押	422	- 	存	₩	柜	梗	₩	iar .	+ =	i inc
#∄	2	RESS.	-ca\$: co t: .	ex	12	- out	ex	424	ook	æ	921

	€	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	27 .	13	4 1	. 51	16	17	1,8	19	20	21 84	8	233
23 23 24	#	· 1 · 4 (图路校园)	#サフエニルシルセスキ オキサン (1.4.7) 10wt名	がリフエニルシルセスキ オキサン (1.4.7) 20wt名	おりつユニルシルセスキ オキサン (1.47), 25mt第	がリフェニルシルセス中 1 オキサン (1.47), 6mt第	ख न	ਜ	子 個	· ·	3 (M)	B C	<u>.</u> П	11 11
	布教館店	(学课)	8-744220 ~4412 (220U) 90mtg .	2-7+420 ~4472 (2200) 80mt§ '	2-7 24 4290 ~4412 (2200), 75#1%	ペンゼン (80℃), 94m t第	T='\- & (154U), 94#t\$	0-x1+21m=2 (1710),94mt8	n-メトキシトルエン (1770)の4mt名	%1#¥~064	27877 944c&	7744 kn 64 (161)	~3 トロール (2071) 94#t≸	ホモベラトロール (220℃), 94m1第
	48	ピンホール 67 止 剤 (商品名)	٦ ¥	# ت	า	າ #	ڻ ب	. า ≉	٦ ¥	າ #	າ້ ນ	נ	น เ	ា - ⊉
		表の状態	42°	CE CE	77. (C. 13).	ez.	- cz(स्र	401	佐	(0)(60K	€E	包
-	**	色序点の成の性	13 13 14) 現	SiOx 197-97 不是 1934年	周上 不良	网上· 不良	刷上不良	· 中 · 小 · 小 · 小 · 小	周上 存	明上校	节石匠	नि स	मार छ
	\$2 \$2	うななるない。	fec	. ke	体	ftε	. t æ	47	拍	ЯĒ	在	ie:	fl.	#
	***	A	ea .	ব্ৰ	œt	æ	व्य	σε	ex.	104	-cx	, coet	व्य	o≰ ·

	#3		Q	Œ	ent ·	424	व्य	ex	每	中午	÷ 中 中 田	424	œ	떠	684	cax .
	\$2 \$2	カセの サーク サーク サーク サーク	ħ	存	神	梗	Upp	梅	¥ac.	钟打	好山	年	#	15 6	類	難
	# #	食品 中の 一切 日本	4EX	蛭	Œ	·	不通	不缺	Я	Ħ.	ß	姓.	æ	ea	£ξ	स्य
	#49	類	闹上	同上	平国	S10x付 ソーダ ガラス 器 概	平 国	平闽	同上	阿上	闸上	नश्च	阿比	阿庄.	闽上	距 77
ļ	***	使の状態	無	ĘĘ,	424	· ex	10	E	À	æ	Ħ	Ą	は大阪の	a⊈ F	A ⊡	কং
-	改	お 全 パンサー4 (名 代) (衛 田 の ()	2 - でセチルシシロ ソルビタンモノ キレエート (NIKKOL-S0-10) (220で195mt名 1mt名	がりオキシスチレン ノニルフエニルエ・テル (N IXKOL-NP-2) 1mt名	9かりルトリメチル 7ンモニウムシロー9イド (コータミン24F) 1また第	3-7セテルショロ ボリオキシエチレン トルキルイン (アキート105) (2201), 93mt第 1mt第	901ル 硫 敬 7ンモニウム 敬 敬 7ンモニウム 敬 敬 1xマールAD-25K)	バルビタンモノ 9ウレート (ノニオンLP-20R) 1wt第	#リオキシエチレン オラチャフエニルエーデル (Nowcol 864) Lat名	7クリルボリマー 同 と (MS 2003) 1mt名	7カリルボリマー 時 1: (MM 2005) 1 m t 名	7ン電系界面倍性 同・上 剤 (P-173) 1wt名	ジフエチルジメトキシ 同 L シテン(KDH 202) 1mt名	/ オルトリメトキン 同 [: シラン(KBM 103) 1mt名	メチルソエニル ジメトキシララン (KBM 112) J#4名	ジャイルボリ シロキサン (SH-200) : Iwt 新
23	南 布	ボ リ マ (相対粘度)	-2 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	я 64	阿上	ボリフエニルシルセスキ 2- オキナン (1.47), 6mt第 (2	נט ר	王 則	7 19	EE Ti	'子 '国	豆	EE	· 恒	Ed E	医
	#	H P	7 2	Æ 25	26	27	28	8 29	30	31	32	FR 33	34	35	9g .	铁石

	#3	既後度	421	-02(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	æx	森	æ	æκ	च्य	व्य
İ	存盛	ビ ン ホール の有無	фр Д	Æ	¥	羅	群	羅	概	難	₿.
	Æ	務 原 原さの 均一性	44	Фť	æ	ਖ	不良	og t	Ŗ	æ	व्ह
	**	板.	4回	可是	810x (掛/-学 ガラス観	阿上	ME	ゾ- ダ ガラス 顔	T102 約7-9 初7-4数	Ing 6.	9 T & 2 - H 2 - 5
	1614	作の状態	ø	. 124	Œ	ধ	號	Ož.	Ą	æ	eε
		ビンホール 防 止 剤 (歯晶名)	シナチルボリ シロキヤン (SH-200) QOの5mt系	ジメチルボリ シロキサン (SH-200) 5wt#	ジメチルポリシロキサン (SH-200) 5 wtst	9x+n#1900+45 (SH-200) 10mt&	9/40*9204\$2 (8H-200) 15#t%	タメチルボリシロキサン (SH-200) 1*t名・	闽	T De	五
	低量級	(概念)	2-7+41290 ~4412 (220U) 93995mt\$	2-7+4200 -4420 (220U) 9399#t\$	2-7七チルシクロ ヘキサノン (220℃) 8]Wt\$	2-Tセチルシクロ ヘキサンン (220℃) 84mt第	2-7+5/200 \44/2 (220U) 79#t\$	2-7セチルシクロ ヘキサイン (220℃) 95wt第	E	<u>Б</u>	<u>E</u> .
₹	**	キリマー (単対結束)	阿上	구 교 .	がリフエニルシルセスキ オキサン (1.47), 6 WL第	E	-	년 고	. T	便	<u>п</u>
ſ	屈		38	33	9	41	å	43	44	4.5	ŝ
	1	112	书表底	*	((2 3 3		光数			ME 85	

第1頁の続き

⑦発 明 者 横野中

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑦発 明 者 磯貝時男

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑩発 明 者 松山治彦

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

@発 明 者 東和文

茂原市早野3300番地株式会社日 立製作所茂原工場内

①出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目1番 1号